УДК 548:54:11

ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУР ЙОДНОВАТОЙ КИСЛОТЫ В ПОРИСТЫХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА

© 2020 г. В. В. Березкин^{*a*, *}, С. А. Бедин^{*a*, *b*}, А. Б. Васильев^{*a*}, Ю. В. Григорьев^{*a*}, В. П. Назьмов^{*c*}

^аИнститут кристаллографии им. А.В. Шубникова ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН, Москва, 119333 Россия

^b Московский педагогический государственный университет, Москва, 111999 Россия ^c Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, 630090 Россия *e-mail: berezkin38@mail.ru

> Поступила в редакцию 16.06.2019 г. После доработки 22.07.2019 г. Принята к публикации 27.07.2019 г.

Методом облучения полимерной пленки синхротронным излучением через маску и последующего химического травления зон деструкции получены полимерные пленки с регулярными порами, направленными перпендикулярно поверхности. Проведены оптические и электронно-микроскопические исследования регулярных и нерегулярных пористых структур. Наблюдаемая дифракция на регулярной пористой полимерной пленке показала перспективу ее использования в качестве дифракционного элемента. На основе пористой полимерной пленки шаблонным методом получены диэлектрические микроструктуры йодноватой кислоты HIO₃.

Ключевые слова: регулярные и нерегулярные пористые системы, дифракция, шаблонный синтез, диэлектрические микроструктуры.

DOI: 10.31857/S1028096020020041

введение

Получение микрокристаллических диэлектрических и металлических композитных микрои наноструктур с одинаковыми поперечными размерами необходимо для их использования при создании систем управления электромагнитным излучением оптического и рентгеновского диапазонов, элементов устройств хранения информации и оптоакустических устройств [1-4]. Одним из методов создания таких микроструктур является шаблонный синтез с применением пористых полимерных пленок [5, 6]. Идентичность размеров создаваемых в пленках микроструктур является важным критерием возможности их практического применения. Получение дополнительных функциональных преимуществ микроструктур за счет уменьшения размеров элементов возможно при использовании пленки с несквозными порами. Ранее было показано, что при принудительном течении пересыщенного раствора йодноватой кислоты (НІО₃) через поры трековой мембраны образуются игольчатые кристаллические микроструктуры с характерной огранкой [7].

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

С целью получения пленки с регулярным расположением пор полимерную пленку облучали синхротронным излучением из накопителя электронов ВЭПП-3 (Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН) перпендикулярно ее поверхности через маску в виде титановой мембраны толщиной 2 мкм [8]. На рис. 1 представлена микрофотография маски. Регулярные поры формировали путем травления пленки в водном 10%-растворе NaOH при температуре 60°С в течение 30 мин, затем ее промывали в дистиллированной воде.

Пористые пленки с хаотичным расположением пор — полимерные трековые мембраны получены в Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова (ОИЯИ, Дубна) в процессе облучения полиэтилентерефталатной пленки ускоренными ионами Хе на циклотроне У-300 и последующего химического травления треков. Такие мембраны характеризуются небольшим разбросом диаметров (не более 5%) и цилиндрической формой пор [9]. Диаметр пор образцов составлял 0.7 мкм, плотность пор 2 × 10⁷ см⁻². пленки и составляла 10 мкм. Микрофотографии поверхности и скола сформированной регулярной пористой микроструктуры свидетельствуют о цилиндрической геометрии пор и шероховатости их поверхности (рис. 2, 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

готовку не проводили. Регулярная система пор, образовавшаяся в результате травления, характеризовалась соответствующими параметрами маски: расстояние между центрами пор 2.9 мкм, диаметр пор 1 мкм, поверхностная плотность пор 10⁶ см⁻². Длина пор соответствовала толшине

Были проведены исследования дифракции света на структуре с регулярной системой пор. Источником света служил Не—Ne-лазер. Использовали схему дифракции "на просвет", экран был расположен на расстоянии 0.5 м от мембраны. Дифракционная картина на регулярной мембране (рис. 4) представляла собой массив светлых рефлексов, локализация которых соответствовала картине дифракции на двумерной периодической структуре. Рефлексы локализованы на пересечении горизонтальных и вертикальных линий, для каждой из которых выполняется условие максимума:

$$d_1 \sin \theta_1 = n_1 \lambda \quad (n_1 = \pm 1, 2, ...),$$
$$d_2 \sin \theta_2 = n_2 \lambda \quad (n_2 = \pm 1, 2, ...),$$

где d_1 и d_2 — периоды такой двумерной регулярной структуры, $d_1 = d_2$, θ_1 и θ_2 — углы дифракции, n порядок дифракции, λ — длина волны излучения. В рассматриваемом случае $d_1 = d_2$ (расстояние между центрами пор), $\theta_1 = \theta_2$. Явление дифракции на полученной пористой структуре также подтвердило ее регулярность. Применение систем с регулярно локализованными и перпендикулярными их поверхности порами и изготовленных на их основе диэлектрических и металлических микроструктур актуально в области создания новых оптических и электронных устройств.

Полученные пористые структуры использовали в качестве основы для формирования микроструктур HIO₃. Пористую пленку погружали в пересыщенный до 11% раствор при температуре 87° С. Затем пленку охлаждали в растворе до температуры 45°С и высушивали при комнатной температуре. В результате в порах формировались микроструктуры (рис. 5, 6), отличные от микроструктур, формирующихся при принудительном течении через микропоры пересыщенного раствора HIO₃. На облученной регулярной полимерной пленке также наблюдалась дифракция света, но менее интенсивная, чем в случае протравленной пленки.



10 мкм



Рис. 2. РЭМ-изображение поверхности регулярной пористой структуры.



Рис. 3. РЭМ-изображение скола регулярной пористой структуры.

Для визуализации поровой структуры полученных образцов применяли растровые электронные микроскопы (РЭМ) FEI Scios (30 кВ) и FEI Quanta 200 3D (30 кВ) с энергодисперсионным детектором EDAX. Специальную пробопод-



Рис. 4. Картина дифракции на регулярной пористой структуре.



Рис. 5. РЭМ-изображение поверхности регулярной пористой пленки, выдержанной в пересыщенном растворе HIO₃.



Рис. 6. РЭМ-изображение скола пленки со сквозными порами, выдержанной в пересыщенном растворе HIO₃.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дифракция на системе пор в пленке, полученных в результате облучения через регулярную маску и последующего травления пленки, показывает регулярность их расположения и идентичность геометрии. Развитый метод шаблонного синтеза позволяет создавать регулярные микро- и наноструктуры на площадях размером порядка десятков квадратных сантиметров. Полученные в работе результаты могут быть использованы при создании элементов, способных модифицировать оптическое излучение, например, фотонных кристаллов, в том числе двумерно упорядоченных. Микроструктуры из нелинейных диэлектриков типа фазированной антенной решетки позволяют значительно увеличить сигнал второй гармоники по сравнению с генерацией в однородном объеме, что существенно расширяет возможности регистрации излучения за счет преобразования его частоты [10].

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках Государственного задания ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН в части выращивания диэлектрических микроструктур и РФФИ (грант № 18-29-20090) в части получения регулярных мембран и рассмотрения возможности их применимости для решения задач фотоники.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Семенов В.Г., Бедин С.А., Асадчиков В.Е., Васильев А.Б. // Письма в ЖТФ. 2018 Т. 44. № 14. С. 66.
- Müller L., Käpplinger I., Biermann S. et al. // J. Micromech. Microeng. 2014. V. 24. P. 035014.
- 3. *Zhan Zh., Xu R., Zheng X. et al.* // Nanotechnology. 2016. V. 27. P. 445301.
- 4. *Groβ P., Esmann M., Becker S.F. et al.* // Adv. Phys.: X. 2016. V. 1. P. 297.
- Dobrev D., Baur D., Neumann R. // Appl. Phys. A. 2005. V. 80. P. 451.
- Mchedlishvili B.V., Asadchikov V.E., Vilenskii A.I. et al. // Crystallogr. Rep. 2003. V. 48. P. S140.
- 7. Васильев А.Б., Березкин В.В., Артемов В.В., Мчедлишвили Б.В. // Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтрон. исслед. 2013. № 9. С. 35.
- Nazmov V.P., Pindyurin V.F., Mishnev S.I., Yakovleva E.N. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B. 2001. V. 173. P. 311.
- 9. Флеров Г.Н. // Вестн. АН СССР. 1984. № 4. С. 35.
- 10. Гапоненко С.В., Розанов Н.Н., Ивченко Е.Л. и др. Оптика наноструктур. СПб: Недра, 2005. 326 с.

Formation of HIO₃ Microstrucrures in Porous Systems on the Basis of Poyethylene Terephtalate

V. V. Berezkin^{1, *}, S. A. Bedin^{1, 2}, A. B. Vasiliev¹, Yu. V. Grigoriev¹, V. P. Nazmov³

¹Shubnikov Institute of Crystallography of Federal Scientific Research Centre "Crystallography and Photonics" RAS, Moscow, 119333 Russia

> ²Moscow State Education University, Moscow, 119991 Russia ³Budker Institute of Nuclear Physic SB RAS, Novosibirsk, 630090 Russia *e-mail: berezkin38@mail.ru

Polymer films with regular pores directed perpendicularly to the surface were obtained by irradiating a polymer film with synchrotron radiation through a mask and subsequent chemical etching of destruction zones. Optical and electron microscopic studies of regular and irregular porous structures were carried out. The diffraction on a regular porous polymer film proved the prospect of its use as diffraction component. On the basis of a porous polymer film, the dielectric microstructures of iodic acid HIO₃ were obtained using the template method.

Keywords: regular and irregular porous systems, diffraction, template synthesis, dielectric microstructures.